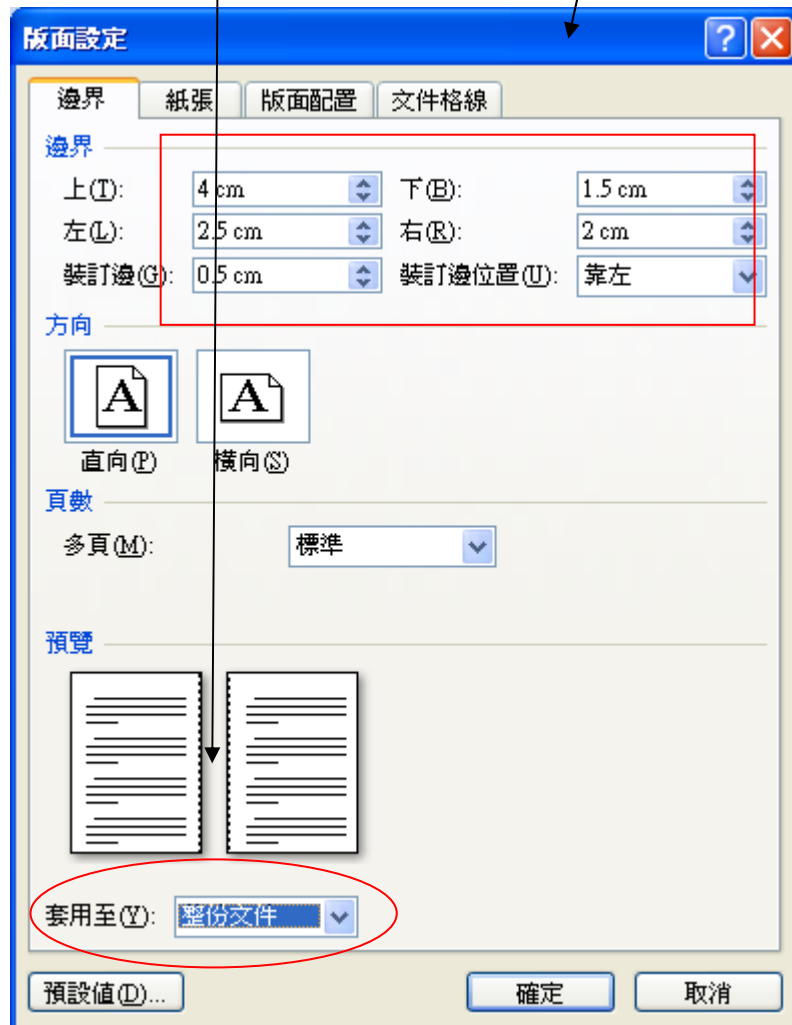


<步驟 1> 確認「版面設定」:(邊界問題)====>上、下、左、右及裝訂邊之邊界距離

請先將格式「套用至:整份文件」再調整邊界數據為

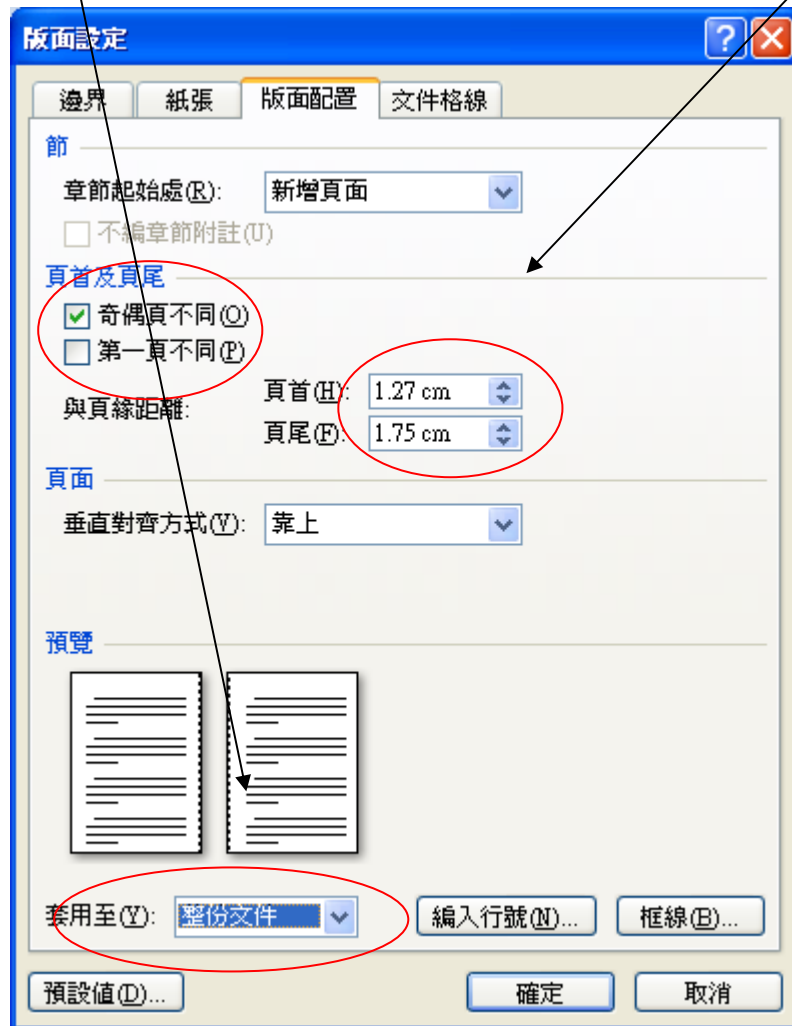
上:4cm/下 1.5cm/左 2.5cm/右:2cm/裝訂邊 0.5cm



<步驟 2> 確認「版面設定」:(版面配置問題)=====>(頁首、頁尾)與頁緣距離

請先將格式「套用至:整份文件」後，只勾選「奇偶頁不同」再調整與頁緣距離數據

為頁首:1.27cm; 頁尾:1.75cm



<步驟 3> 確認「文章摘要」:(中英文字數)=====> 中、英文摘要字數以 250 字為上限，若

文章題目、作者資料及中英文摘要無法排進第一頁，敬請作者修正字數。

選取摘要範圍/校閱/ABC

The screenshot shows a Microsoft Word document titled "(P163-174)-No-395 氮氧化層氮化技術對SONOS快閃記憶體.doc [相容模式] - Microsoft Word". The ribbon is set to "校閱" (Review). A "字數統計" (Word Count) dialog box is open, showing the following statistics:

統計:	值
頁數	1
字數	281
字元數 (不含空白)	317
字元數 (含空白)	319
段落數	1
行數	8
半形字	9
全形字	272

The document content includes the following text:

摘要

本研究藉由製作以一氧化二氮氧化法與一氧化氮退火法等兩種氮化技術所成長的穿隧氧化層並分析其影響 SONOS 快閃記憶體可靠性特性。結果發現雖然一氧化二氮氧化法 900°C 高溫製程無法產生預期的電荷保存能力，並藉由電荷升壓法(charge pumping)驗證一氧化二氮氧化法之氮原子無法有效降低介面缺陷，但其耐電荷重複抹寫的能力較佳，另一方面在高溫熱沉積成長穿隧氧化層再配合一氧化氮退火法的結果顯示，可同時提升元件漏電流特性、耐電荷重複抹寫與資料保存能力，足以推證一氧化氮退火法之氮原子可經由擴散而堆積在介面上，改善氧化層的品質，並具有節省熱成本(thermal budget)的優點，本實驗結果可提供 SONOS 快閃記憶體可靠性提升之有效方法。

關鍵詞：SONOS，快閃記憶體

The Study of Charge Retention Characteristics of SONOS Flash Memory with Nitridation Tunnel Oxide

Jia-Lin Wu^{1*}, Chin-Hsiung Wu², Je-Chuang Wang⁴, and

¹School of Defense Science and Engineering, National Defense University

²Semiconductor Lab., National Defense University

³Department of Electronic and Electrical Engineering, National Defense University

⁴Department of Applied Chemistry and Material Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense University

ABSTRACT

The reliability characteristics of SONOS (silicon-oxide-nitride-oxide-silicon) devices with different thin nitridation tunnel oxides are studied. Although the device with the tunnel oxynitride grown in N₂O ambient at 900°C can not reach the expected retention, it still has better endurance

At the bottom of the screenshot, the status bar shows: 頁面: 1 / 12 | 字數: 281 / 11,580 | 中文 (台灣) | 插入 | 100%

